

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заведующего лабораторией
в лаборатории физики полупроводниковых приборов.
Вакансия VAC 128927

Тематика исследований

Исследования технологии получения и структурного совершенства новых полупроводниковых материалов, разработки технологии формирования приборов на их основе, исследования процессов деградации характеристик приборов в случае работы экстремальных условиях эксплуатации, поиск путей оптимизации параметров приборов различных типов.

Трудовая деятельность

- постановка цели и задач научно-исследовательских работ в рамках тематики Государственного задания и научных проектов лаборатории, организация рабочего взаимодействия членов коллектива, контроль за материальным и техническим обеспечением научного коллектива, необходимым для успешной реализации проводимых в лаборатории исследований;
- осуществление контроля за выполняемой членами научного коллектива работой, её соответствием целям и задачам лаборатории, высокому уровню качества, а также плану работ и срокам их реализации;
- анализ и обсуждение результатов членов научного коллектива, ориентация результатов на публикацию в рецензируемых научных изданиях и представление в форме докладов на конференциях и семинарах;
- руководство в подготовке публикаций в рамках отчетности лаборатории по выполнению Государственного задания в форме статей, заявок на изобретения, докладов на конференциях, а также взаимодействие с внешними научными коллективами;
- обобщение полученных результатов и их представление в отчетных документах и выступлениях; подготовка основных выводов и отчетных материалов по работе; взаимодействие с административными сотрудниками и службами Института;
- корректировка плана исследований, расходов по научно-исследовательским проектам лаборатории, а также состава научного коллектива и распределения работ в процессе достижения поставленных цели и задач.

Требования к претенденту

- ученая степень доктора физико-технических наук по специальности физика полупроводников;
- наличие опыта руководства научными подразделениями не менее 15 лет;
- наличие не менее 30 публикаций WoS/Scopus в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. не менее 10 из них – в изданиях Q1\ Q2) за последние 5 лет;
- наукометрические показатели: индекс Хирша (WoS) – не ниже 18, индекс цитирования (WoS) – не ниже 1500;
- наличие именной премии ФТИ и премии Правительства С.-Петербурга;
- наличия опыта успешного завершения научных проектов Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ);
- наличие опыта педагогической деятельности, в том числе – опыта руководства диссертационными работами магистрантов и аспирантов;
- наличие опыта участия в экспертно-аналитической и общественно-организационной деятельности.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 37 634 руб.
- СТАВКА: 0,1
- Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.